











|   |   |
|---|---|
|  | <h2>SI1967DH-T1-GE3</h2>  |
|   | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI1967DH-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 20V 1.3A SC70-6</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI1967DH-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 12000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |   |

### Spezifikationen

|  |  |
|--|--|
| Teilenummer                                      | SI1967DH-T1-GE3                                  |
| Hersteller                                       | Electro-Films (EFI) / Vishay                     |
| Beschreibung                                     | MOSFET 2P-CH 20V 1.3A SC70-6                     |
| Kategorie  | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus                                       | 12000 pcs Stock                                  |
| detaillierte Beschreibung                        | Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 1.3A 1.25W   |
| Serie  | TrenchFET®                                       |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)                               |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount                                    |
| Leistung - max                                   | 1.25W  |
| Verpackung / Gehäuse                             | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363                          |
| Supplier Device-Gehäuse                          | SC-70-6 (SOT-363)                                |
| Typ FET  | 2 P-Channel (Dual)                               |
| FET-Merkmal                                      | Logic Level Gate                                 |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 20V  |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 1.3A   |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 490 mOhm @ 910mA, 4.5V                           |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 1V @ 250µA                                       |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 4nC @ 8V   |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 110pF @ 10V                                      |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)                                 |
| Basisteilenummer                                 | SI1967   |
| Bleifreier Status / RoHS-Status                  | Lead free / RoHS Compliant                       |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)        | 1 (Unlimited)                                    |
| Andere Namen                                     | SI1967DH-T1-GE3TR                                |

SI1967DH-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1967DH-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1967DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1967DH-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|  <p><b>SI1970DH-T1-E3</b><br/>Vishay / Siliconix<br/>MOSFET 2N-CH 30V 1.3A SC70-6</p>            |  <p><b>SI1967DH-T1-E3</b><br/>Vishay / Siliconix<br/>MOSFET 2P-CH 20V 1.3A SC70-6</p>           |  <p><b>SI1967DH</b><br/>Vishay Precision Group<br/>SI1967DH Vishay</p>                 |  <p><b>SI1965DH-T1-GE3</b><br/>Vishay / Siliconix<br/>MOSFET 2P-CH 12V 1.3A SC70-6</p> |
|  <p><b>SI1970DH-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET 2N-CH 30V 1.3A SC70-6</p> |  <p><b>SI1970DH-T1-E3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET 2N-CH 30V 1.3A SC70-6</p> |  <p><b>SI1967DH-T1-GE3</b><br/>Vishay / Siliconix<br/>MOSFET 2P-CH 20V 1.3A SC70-6</p> |  <p><b>SI1969DH-E3</b><br/>VISHAY<br/>SI1969DH-E3 VISHAY</p>                           |

### heiße Teile

Mehr

|                    |                    |                      |                   |                    |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| ⚙ SI1905DL-T1      | ↔ SI1905DL-T1-E3   | ➔ SI1905DL-T1-E3     | D SI1905DL-T1-GE3 | ➔ SI1906DL-T1      |
| ⊣ SI1912EDH        | ⚙ SI1912EDH-T1     | D SI1912EDH-T1-E3    | ➔ SI1912EDH-T1-E3 | ➔ SI1912EDH-T1-GE3 |
| ⚙ SI1913DH-T1-E3   | ⊣ SI1913DH-T1-E3   | ⚙ SI1913DH-T1-GE3    | ↔ SI1913EDH-T1    | ➔ SI1913EDH-T1-E3  |
| D SI1913EDH-T1-E3  | ⚙ SI1913EDH-T1-GE3 | ⊣ SI1917EDH-T1       | ⚙ SI1917EDH-T1-E3 | ➔ SI1917EDH-T1-E3  |
| ➔ SI1917EDH-T1-GE3 | ↔ SI1922EDH-T1-GE3 | ⚙ SI1922EDH-T1-GE3   | ⊣ SI1926DL-T1-E3  | ➔ SI1926DL-T1-E3   |
| ↔ SI1926DL-T1-GE3  | ➔ SI1926DL-T1-GE3  | D SI1958DH-T1-E3     | ⚙ SI1958DH-T1-E3  | ⊣ SI1965DH-E3      |
| ⚙ SI1965DH-T1-E3   | D SI1965DH-T1-E3   | ➔ SI1965DH-T1-GE3    | ↔ SI1965DH-T1-GE3 | ➔ SI1967DH-T1-E3   |
| ⊣ SI1967DH-T1-E3   | ⚙ SI1967DH-T1-GE3  | ↔ SI1969DH-E3        | ➔ SI1970DH-T1-GE3 | ➔ SI1970DH-T1-GE3  |
| ⚙ SI1972DH-T1      | ⊣ SI1972DH-T1-E3   | ⚙ SI1972DH-T1-E3     | D SI1972DH-T1-GE  | ➔ SI1972DH-T1-GE3  |
| ↔ SI1972DH-T1-GE3  | ⚙ SI1973DH-E3      | ⊣ SI1983DT-285-T1-E3 | ⚙ SI1988DH-T1-GE3 | ➔ SI1988DH-T1-GE3  |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited